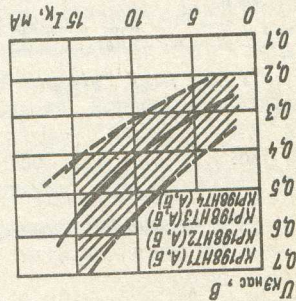
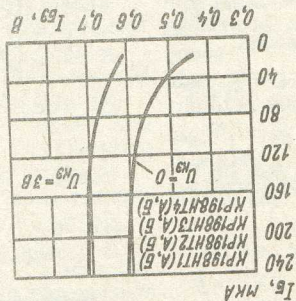


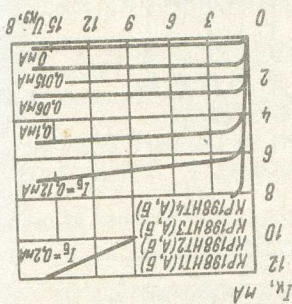
Зависимости напряжения насыщения коллектора — эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока коллектора при  $I_B = 0,5$  мА. Заштрихованная область разброса значений параметров для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость



Зависимости тока базы транзисторов, входящих в состав микросхем, от напряжения база — эмиттер



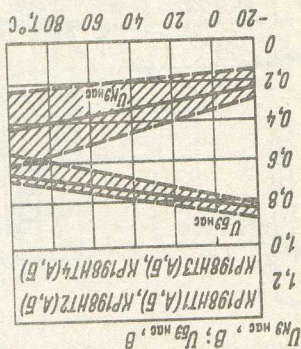
Выходные вольт-амперные характеристики транзисторов, входящих в состав микросхем



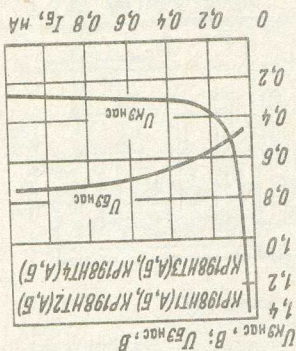
Зависимости обратного тока коллектора транзисторов, входящих в состав микросхем от температуры окружающей среды. Заштрихованная область разброса значений параметров для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость



Зависимости напряжения насыщения коллектора — эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды при  $I_B = 0,7$  мА,  $I_k = 3$  мА. Заштрихованная область разброса значений параметров для 95% микросхем. Сплошной линией показаны типовые зависимости



Зависимости напряжения насыщения коллектора — эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока базы при  $I_k = 3$  мА



Постоянное напряжение коллектора — база — эмиттер ..... 15 В  
Постоянное напряжение коллектора — база — эмиттер ..... 15 В

Предельные эксплуатационные данные

Разброс прямых напряжений база — эмиттер KP198HT2A, KP198HT2B, не более 15%  
Разброс значений статического коэффициента передачи тока дифференциальной пары в микросхемах KP198HT1A, KP198HT1B, не более 4 мВ

Обратное напряжение база — эмиттер ..... 15 В  
Обратное напряжение база — эмиттер ..... 4 В  
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения ..... 10 мА  
Постоянный ток коллектора ..... 30 мА  
Постоянная рассеиваемая мощность в диапазоне температур окружающей среды  $T = -45 \dots +85$  °C  
одним транзистором ..... 20 мВт  
матрицей ..... 100 мВт  
Температура окружающей среды .....  $-45 \dots +85$  °C